# UM2001A TWI 使用注意事项

版本: V1.2



广芯微电子 (广州) 股份有限公司

http://www.unicmicro.com/

AN2204 条款协议

#### 条款协议

本文档的所有部分,其著作产权归广芯微电子(广州)股份有限公司(以下简称广芯微电子) 所有,未经广芯微电子授权许可,任何个人及组织不得复制、转载、仿制本文档的全部或部分组件。 本文档没有任何形式的担保、立场表达或其他暗示,若有任何因本文档或其中提及的产品所有资讯 所引起的直接或间接损失,广芯微电子及所属员工恕不为其担保任何责任。除此以外,本文档所提 到的产品规格及资讯仅供参考,内容亦会随时更新,恕不另行通知。

- 本文档中所记载的关于电路、软件和其他相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用实例。
   用户如在设备设计中应用本文档中的电路、软件和相关信息,请自行负责。对于用户或第三方因使用上述电路、软件或信息而遭受的任何损失,广芯微电子不承担任何责任。
- 在准备本文档所记载的信息的过程中,广芯微电子已尽量做到合理注意,但是,广芯微电子并不保证这些信息都是准确无误的。用户因本文档中所记载的信息的错误或遗漏而遭受的任何损失、广芯微电子不承担任何责任。
- 3. 对于因使用本文档中的广芯微电子产品或技术信息而造成的侵权行为或因此而侵犯第三方的专利、版权或其他知识产权的行为,广芯微电子不承担任何责任。本文档所记载的内容不应视为对广芯微电子或其他人所有的专利、版权或其他知识产权作出任何明示、默示或其它方式的许可及授权。
- 4. 使用本文档中记载的广芯微电子产品时,应在广芯微电子指定的范围内,特别是在最大额定值、电源工作电压范围、热辐射特性、安装条件以及其他产品特性的范围内使用。对于在上述指定范围之外使用广芯微电子产品而产生的故障或损失,广芯微电子不承担任何责任。
- 5. 虽然广芯微电子一直致力于提高广芯微电子产品的质量和可靠性,但是,半导体产品有其自身的具体特性,如一定的故障发生率以及在某些使用条件下会发生故障等。此外,广芯微电子产品均未进行防辐射设计。所以请采取安全保护措施,以避免当广芯微电子产品在发生故障而造成火灾时导致人身事故、伤害或损害的事故。例如进行软硬件安全设计(包括但不限于冗余设计、防火控制以及故障预防等)、适当的老化处理或其他适当的措施等。

## 目录

1	摘安		ت	
2	TWI 操作说明			
	2.1	未烧录参数芯片		
	2.2	烧录默认参数	3	
	2	.2.1 烧录默认参数的原因	4	
	2.3	操作 Reg3F 命令说明	4	
3	TWI 打开操作流程			
	3.1	唤醒(上电)	4	
	3.2	进入 TWI 模式	4	
	3.3	测试 TWI	5	
4	参考示	<b>示例</b>		
	4.1	定义	5	
	4.2	TWI 读写字节	5	
	4.3	TWI 操作	7	
5	总结		10	
4		%ì⊤	11	

AN2204 摘要

## 1 摘要

本篇应用笔记介绍 TWI 使用注意事项及配置流程。TWI (Two-Wire Interface) 作为 UM2001A 的串行通信接口,在 UM2001A 芯片中有着特定的使用规范和操作流程。确保芯片与外部设备之间稳定、高效的通信至关重要。

本篇应用笔记主要包括:

- TWI操作说明
- TWI打开操作流程
- 参考示例
- 总结

# 2 TWI 操作说明

TWI 在线配置模式可对以下 2 种情况的芯片进行在线配置,分别为未烧录参数的芯片和已烧录默认参数的芯片,本应用中的 OTP 未烧录参数和 OTP 已烧录参数,仅考虑寄存器 Reg1A/Reg1B/Reg1C/Reg1D 是否已被烧录参数。

#### 2.1 未烧录参数芯片

未烧录参数是指芯片 OTP 寄存器 Reg1A=0x00, Reg1B=0x00, Reg1C=0x00, Reg1D=0x00, 芯片唤醒后,等待芯片上电稳定后芯片会一直处于 TWI 窗口时间等待 TWI 打开时序。

### 2.2 烧录默认参数

烧录默认参数是指芯片 OTP 寄存器 Reg1A=0x01,Reg1B=0x00, Reg1C=0x79, Reg1D=0x3F,芯 片唤醒后,等待芯片上电稳定后,芯片会处于极低速率发射状态,发射完成后芯片会重新进入睡眠 AN2204 TWI 打开操作流程

状态,所以 TWI 时序需要在上电稳定后并在进入睡眠前发送,默认参数是一个非常低的速率,使有充足的时间接收 TWI 打开时序,进入 TWI 模式。

#### 2.2.1 烧录默认参数的原因

在低功耗应用中,如果芯片没有烧录默认参数,芯片可能会因 CLK 或 DATA 脚的异常抖动导致误唤醒,而 MCU 又不会对芯片进行 TWI-OFF 操作。这种情况下,芯片会一直处于 IDLE 状态(耗电约 1mA 左右)直到 MCU 完成下一次的正常唤醒/休眠操作。若芯片写入默认参数后,芯片误唤醒后仍然会重新进入睡眠状态。

### 2.3 操作 Reg3F 命令说明

在读写 Reg3F 命令寄存器时,需要在操作 Reg3F 前需要先复位 TWI,即发送连续 50 个 TWI CLK 时钟,TWI Data 引脚保持低电平后再对 Reg3F 进行操作。

# 3 TWI 打开操作流程

TWI 打开操作流程分为 3 步, 分别为唤醒 (上电)、进入 TWI 模式、测试 TWI。

## 3.1 唤醒(上电)

通过拉低 TWI 的 CLK 引脚唤醒芯片,低电平时间需要保持至少 1.5ms 时间后拉高。芯片唤醒稳定后进入 TWI 窗口。

#### 3.2 进入 TWI 模式

芯片唤醒后, 发送 TWI 打开时序进入 TWI 模式, 即 TWI 的 Data 引脚保持低电平, TWI 的 CLK发送 50 个时钟。

#### 3.3 测试 TWI

测试 TWI 接口是否可以正常读取寄存器值,需要先进行 TWI 复位,即发送 50 个 TWI CLK 时钟, TWI 的 DATA 引脚保持低电平。然后读取寄存器 Reg3F, 判断寄存器 Reg3F 的值是否为 0x17,若是则说明芯片已进入 TWI 配置状态,可以正常配置芯片,否则发送 TWI OFF 时序,然后重复以上步骤。

# 4 参考示例

#### 4.1 定义

#define TWI\_CLK\_DIR\_OUTPUT /\* 设置为输出 \*/ /\* 输出低电平 \*/ #define TWI\_CLK\_LEVEL\_LOW /\* 输出高电平 \*/ #define TWI CLK LEVEL HIGH #define TWI\_DATA\_DIR\_INPUT /\* 设置为输入 \*/ /\* 设置为输出 \*/ #define TWI DATA DIR OUTPUT /\* 输出低电平 \*/ #define TWI DATA LEVEL LOW /\* 输出高电平 \*/ #define TWI DATA LEVEL HIGH #define TWI\_DATA\_LEVEL\_READ /\* 读取电平 \*/

### 4.2 TWI 读写字节

```
/* 拉高 sclk 脚电平 */
   TWI_CLK_LEVEL_HIGH;
   for(uint8_t i=0;i<8;i++)
   {
                                                 /* 高位如果为 1 则拉高电平 */
       if(byte&0x80)
       {
           TWI_DATA_LEVEL_HIGH;
       }
       else
       {
                                                 /* 为 0 则拉低电平 */
           TWI_DATA_LEVEL_LOW;
                                                 /* 拉低电平 */
       TWI CLK LEVEL LOW;
                                                 /* 拉高电平 */
       TWI_CLK_LEVEL_HIGH;
       byte <<= 1;
                                                 /* 左移 1 位 */
   }
   TWI_CLK_LEVEL_HIGH;
   TWI_DATA_LEVEL_HIGH;
}
/********
* Function
               : twi_read_byte
* Description
               : twi 读一个字节
* Input
               : none
 * Output
               : none
 * Return
               : uint8_t
uint8_t twi_read_byte(void)
   TWI_DATA_DIR_INPUT;
                                                 /* 拉低时钟电平 */
   TWI_CLK_LEVEL_LOW;
   uint8 t value = 0;
   for(uint8_t i=0;i<8;i++)
   {
       value <<= 1;
       TWI_CLK_LEVEL_LOW;
       if(TWI_DATA_LEVEL_READ == 1)
       {
```

```
value++;
      }
      TWI_CLK_LEVEL_HIGH;
   }
   TWI_DATA_DIR_OUTPUT;
                                            /* data 脚设置为输出 */
   TWI_DATA_LEVEL_HIGH;
                                            /* 拉高 clk 脚电平 */
   TWI_CLK_LEVEL_HIGH;
   return value;
}
* Function
             : twi_ reset
* Description
             :TWI 复位
* Input
             : none
* Output
             : none
* Return
             : none
void twi_reset(void)
{
   TWI_DATA_LEVEL_LOW;
   for(uint8_t i=0;i\leq50;i++)
      TWI_CLK_LEVEL_LOW;
                                            /* 拉低电平 */
      TWI_CLK_LEVEL_HIGH;
                                            /* 拉高电平 */
}
```

## 4.3 TWI 操作

```
uint8_t count = 10;
    do
    {
        /* 唤醒 */
        TWI_DATA_LEVEL_LOW;
        TWI_CLK_LEVEL_LOW;
        delay_us(1500);
        TWI_CLK_LEVEL_HIGH;
        /* twi on */
        TWI_DATA_LEVEL_LOW;
        for(uint8_t i=0;i<50;i++)
        {
            TWI_CLK_LEVEL_LOW;
            TWI_CLK_LEVEL _HIGH;
        }
        /* 确认 */
        twi_write_byte(0xBF);
        if(twi_read_byte() == 0x17)
        {
            return SUCCESS;
        }
      twi_off();
    }while(count--);
    return FAILED;}
 * Function
                : twi_off
 * Description
                : 关闭 twi
 * Input
                : none
 * Output
                : none
 * Return
                : none
void twi_off(void)
{
    twi_reset();
```

```
twi_write_byte(0xFF);
    twi_write_byte(0x02);
    delay_us(10000);
                                                              等待芯片完全关闭 */
}
 * Function
                : init
 * Description
                :初始化
 * Input
                : none
 * Output
                : none
 * Return
                : none
em_ret_t init(void)
{
    em_ret_t ret = FAILED;
                                                         /* 初始化 TWI */
    twi_init();
    if(SUCCESS == twi_on())
    {
        um2005C_write_reg(UM2005C_REG3F,UM2005C_REG3F_OPT_READ);
        um2005C_hal_delay_us(50);
        uint8_t reg1A = um2005C_read_reg(UM2005C_REG1A);
        uint8_t reg1B = um2005C_read_reg(UM2005C_REG1B);
        uint8_t reg1C = um2005C_read_reg(UM2005C_REG1C);
        uint8_t reg1D = um2005C_read_reg(UM2005C_REG1D);
        static uint8_t rf_cfg[4] = \{0x01,0x00,0x79,0x3F\};
        if(reg1A == 0x00 \&\& reg1B == 0x00 \&\& reg1C == 0x00 \&\& reg1D == 0x00)
            um2005C_write_reg(UM2005C_REG1A,rf_cfg[0]);
            um2005C_write_reg(UM2005C_REG1B,rf_cfg[1]);
            um2005C_write_reg(UM2005C_REG1C,rf_cfg[2]);
            um2005C_write_reg(UM2005C_REG1D,rf_cfg[3]);
            um2005C_write_reg(UM2005C_REG3F,UM2005C_REG3F_OPT_PROGRAM);
            um2005C_hal_delay_us(500);
            ret = SUCCESS;
        }
```

AN2204 总结

```
else
              {
                   if(reg1A == rf_cfg[0] && reg1B == rf_cfg[1] && reg1C == rf_cfg[2] && reg1D ==
rf_cfg[3])
                   {
                       ret = SUCCESS;
                   }
                   else
                   {
                       ret = FAILED;
                   }
              }
              uint8_t len = sizeof(rf_config)/sizeof(rf_config[0]);
              for(uint8_t i=0;i<len;i++)
              {
                   if(rf_config[i][0] != 0xFF)
                   {
                       um2005C\_write\_reg(rf\_config[i][0],rf\_config[i][1]);\\
                   }
              }
         }
         return ret;
    }
```

# 5 总结

- 1. 操作 Reg3F 前需要发射时序复位 TWI 接口。
- 2. TWI 在线配置未烧录参数或已烧录默认参数的芯片
- 3. 芯片唤醒后,需等待芯片上电稳定后,发送 TWI 打开时序,使芯片进入 TWI 模式。
- 4. TWI 打开需要读取 Reg3F 是否为 0x17 来判断是否可正常读写寄存器。

AN2204 版本修订

# 6 版本修订

版本	日期	描述
V1.0	2025.03.25	初始版
V1.1	2025.04.11	更新 TWI 操作代码
V1.2	2025.09.27	更新 TWI 操作时序